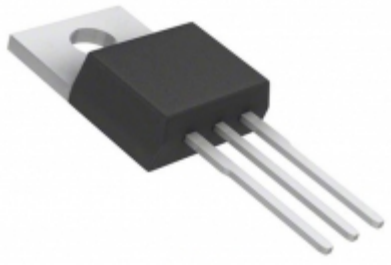



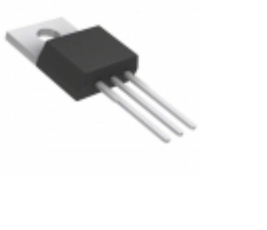




	<h2 style="color: red;">FQP50N06</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP50N06</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP50N06.pdf 2.FQP50N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 65708 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP50N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	65708 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1540pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FQP50N06 ist neu im Original, Suche FQP50N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP50N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP50N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP50N08 FAIRCHILD FQP50N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP50N03C F FQP50N03C F</p>	 <p>FQP50N03 F FQP50N03 F</p>	 <p>FQP50N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p>
 <p>FQP4P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4A TO-220</p>	 <p>FQP4P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A TO-220</p>	 <p>FQP50N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p>	 <p>FQP50N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP44N10F	↔ FQP45N03L	⇒ FQP45N03LM	D FQP45N15V2	⇒ FQP45N15V2
⊣ FQP45N20A	⊗ FQP46N15	D FQP46N15	⇒ FQP47N06	⇒ FQP47P06
⊗ FQP47P06	⊣ FQP47P06L	⊗ FQP47P06_	↔ FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_NW82049
D FQP47P06_SW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	⊣ FQP4N20L	⊗ FQP4N20L	⇒ FQP4N60C
⇒ FQP4N65C	↔ FQP4N90C	⊗ FQP4N90C	⊣ FQP50N03	⇒ FQP50N03C
↔ FQP50N06	⇒ FQP50N06L	D FQP50N06L	⊗ FQP50N08	⊣ FQP55N06
⊗ FQP55N06	D FQP55N10	⇒ FQP55N10	↔ FQP58N08	⇒ FQP58N08
⊣ FQP5N20L	⊗ FQP5N20L	↔ FQP5N50C	⇒ FQP5N50C	⇒ FQP5N60C
⊗ FQP5N60C	⊣ FQP630TSTU	⊗ FQP630TSTU	D FQP65N06	⇒ FQP65N06
↔ FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	⊣ FQP6N40CF	⊗ FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited